

JE-1982-05

47398 E/23 FUJITSU LTD	L03 14.06.75-JP-072578 (18.05.82) H011-21/31 H011-29/78 Metal insulating semiconductor device mfr. - by thermally nitriding silicon substrats, forming two insulating films, etching last film, and forming gate (J5 20.12.76)	FUIT 14.06.75 *J8 2023-429	L(3-D3D) 339
A silicon nitride film as a first insulating film is formed on a Si substrate by thermal nitriding at below 1300°C. A second insulating film e. g. Al_2O_3 is deposited on the silicon nitride film. A thick insulating film e. g. SiO_2 as a third film is deposited on the second insulating film, and selectively etched to expose part of the second insulating film. A gate contact is formed on the exposed part of the second insulating film. (4ppW86).			J82023429

439/4913

⑫特許公報 (B2) 昭57-23429

⑬Int.Cl.³
H 01 L 29/78
//H 01 L 21/318

識別記号
H 01 L 29/78
//H 01 L 21/318

府内整理番号
7377-5 F
7514-5 F
7739-5 F

⑭公告 昭和57年(1982)5月18日
発明の数 1

(全4頁)

1

⑮MIS型半導体装置の製造方法

⑯特 願 昭50-72578
⑯出 願 昭50(1975)6月14日
⑯公 開 昭51-148377
⑯昭51(1976)12月20日

⑯發明者 伊藤隆司
川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社内
⑯發明者 野崎尊夫
川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社内
⑯出願人 富士通株式会社
川崎市中原区上小田中1015番地
⑯代理人 弁理士 松岡宏四郎

⑯特許請求の範囲

1 シリコン基板表面に1300°C以下の温度での熱空化による空化シリコン膜を形成した後、基板上に熱空化による空化シリコンとは異種の第2絶縁膜を被着する工程、基板上に厚い第3絶縁膜を被着する工程、該第3絶縁膜の一部を除去する工程、および該第3絶縁膜が除去された部分の前記第2絶縁膜表面上にゲート電極を設ける工程が含まれることを特徴とするMIS型半導体装置の製造方法。

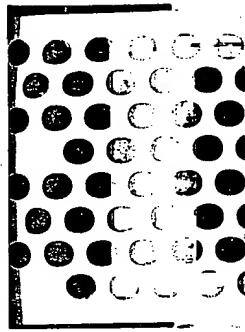
発明の詳細な説明

本発明は、半導体装置、特に金属一絶縁膜一半導体(MIS)構造から成るMIS型半導体装置の製造方法に関する。

従来、MIS型集積回路の基本要素であるMISトランジスタにおいては、高性能化すなわち高速動作、小型化、高信頼性の要求に従つて研究開発が精力的に進められてきた。すなわち、高速動作のためには、キャリアが走行するチャネル長を短くするばかりではなく、寄生容量の低減、配線抵抗の低下は重要な問題である。また益々増大す

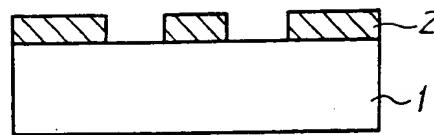
る情報を処理するためには、低消費電力の高密度実装による集積回路は不可欠であり、そのためには小型化は常に指向してきた方向である。また、装置の中核となるMISトランジスタは、高い信頼性を備えていなければならない。しかしながら従来のMISトランジスタの構成は、シリコン(Si)と熱酸化法による二酸化シリコン(SiO₂)膜を中心用い、化学薬品によるエッチングとホトレジスト技術を駆使したものである。このた

め10⁶V/cm程度の高電界が印加される薄いゲート絶縁膜形成において薬品処理あるいはホトレジスト工程での汚染を断つことは難しく、混入したイオンのドリフトや不純物汚染に起因する種々の欠陥のために、高い安定性、信頼性を有する装置の実現は、その製造工程が複雑化するにつれて困難になる。このような問題点について、以下に具体的に説明する。第1図a~eは、標準的なチャネルMISトランジスタの各製造工程における断面図である。先ず、P形Si基板1に厚さ約4000Åの熱酸化SiO₂2を付着し、選択拡散用窓をあける。次に、りんPの高濃度拡散層3、4を形成する。次にチャネル領域の厚いSiO₂膜2を除去して再び熱酸化によって、薄いSiO₂5を形成するが、この工程において、Si基板表面はホトレジスト剝離剤に浸されるため、金属イオンが付着したり、それらを含むSiの自然酸化膜が付着したりする。これは後にMISトランジスタの安定性や、ゲートしきい値電圧の値あるいはばらつきに大きく影響する。これを防ぐためには、ホトレジスト剝離剤を除去した後、HF系の溶液でSiチャネル領域をかるくエッチングすることが有効であるが、フールドオキサイドとなるSiO₂2も同時に溶解してしまうため、一般には行なわれていない。一般には、ただちに薄いSiO₂膜5を形成し、コンタクト窓6、7を形成しAlでソース8、ドレイン9、ゲート10の各電極を形成する。また、このような従来の方法に

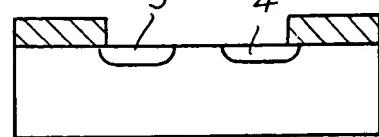


第 1 図

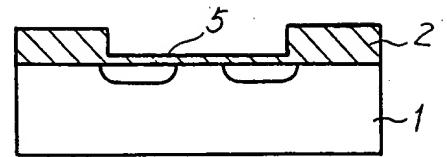
(a)



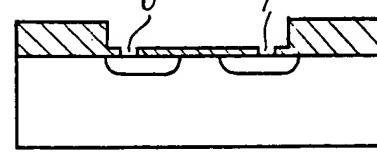
(b)



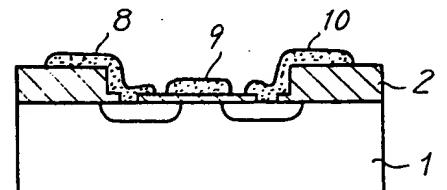
(c)



(d)

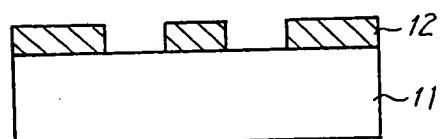


(e)

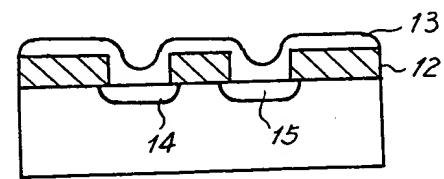


第 2 図

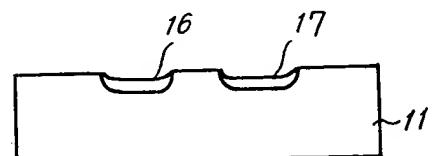
(a)



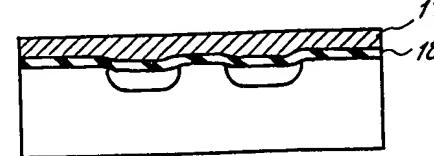
(b)



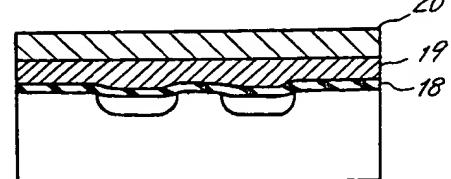
(c)



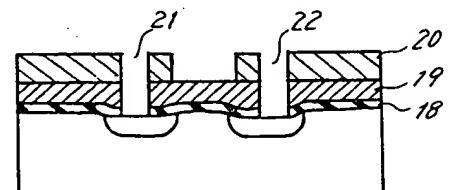
(d)



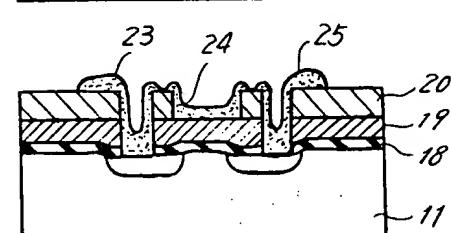
(e)



(f)



(g)



においては、ゲート絶縁膜(SiO_2 膜)へのアルカリイオンの混入が素子特性の安定性に著しい悪影響を与えることは良く知られており、これを防ぐためりんガラスで被覆してアルカリイオンをゲッターする方法や、気相成長による窒化シリコン(Si_3N_4)あるいはアルミナ(Al_2O_3)のようなアルカリイオンの移動を阻止する絶縁膜を被覆している。しかし、その場合にはりんガラスの分極あるいは SiO_2 上に設けた絶縁膜中の電子や正孔トラップの存在により新たな特性不安定現象が現われ問題となる。かかる欠点を除去する一方で、窒素あるいはアンモニアガスを含む雰囲気での1300°C以下の加熱により、 Si 基板表面に熱窒化による窒化シリコン膜を形成し、これをゲート絶縁膜の一部として用いることが本発明者等により提案されている。この熱窒化シリコン膜は、従来知られていた1300°C以上での熱窒化による結晶化の進んだ窒化シリコン膜と異なり、非晶質で緻密な構造を持ち、半導体装置の特性安定化に極めて有効であることが確認された。しかし、1300°C以下の熱窒化のためには、空気中に Si 基板を放置しただけで形成される厚さ15~20Å程度の自然酸化膜をも除去しなければならない。従つて前記した従来の方法にいて、1300°C以下の熱窒化による窒化シリコン膜をゲート絶縁膜の一部に用いる場合、チャネル領域の厚い SiO_2 膜2を除去した後、 Si 基板表面の自然酸化膜をフツ酸等によりできる限り除去しなければならず、その際にフツ酸等の処理液により素子形成領域周囲の厚い酸化膜2がエッチングされてしまうという問題がある。

本発明は以上の点に鑑み、素子形成領域周囲の厚い絶縁膜を必要にエッチングすることなく、汚染のない状態でゲート絶縁膜を形成して、特性安定なMIS型半導体装置を製造する方法を提案するものである。

本発明のMIS型半導体装置の製造方法は、シリコン基板表面に1300°C以下の温度での熱窒化による窒化シリコン膜を形成した後、基板上に熱窒化による窒化シリコンとは異種の第2絶縁膜を被着する工程、基板上に厚い第3絶縁膜を被着する工程、該第3絶縁膜の一部を除去する工程、および該第3絶縁膜が除去された部分の前記第2絶縁膜表面上にゲート電極を設ける工程が含まれ

ることを特徴とするものである。

すなわち、本発明は極めて清浄にされた Si 基板表面に1300°C以下の温度での熱窒化による窒化シリコン膜を予め形成しておき、その後MIS型半導体装置の構成に必要な各種絶縁膜および導体膜を基板上に被着形成するものである。1300°C以下の温度で Si を熱窒化するには、 Si 表面の自然酸化膜を約10Å以下にする必要がある。自然酸化膜を完全に除去することは困難であるが、フツ酸による処理の後、水中への浸漬や空気へ晒すことをできる限り避けることにより、自然酸化膜の生成を6~7Åの厚さに抑えることができる。熱窒化による窒化シリコン膜の成長は、生成した窒化シリコン膜中のシリコンあるいは窒素原子の拡散によるため、成長に伴つて成長速度は低下し、1300°C以下の温度での熱窒化では、膜厚は約100Å程度が最大限度である。熱窒化の際の雰囲気としては窒素あるいはアンモニアガスに不活性ガスを加えてもよい。このようにして得られた窒化シリコンは構造緻密でアルカリイオンの移動を妨げ、また気相成長の場合とは異なり、 Si との界面に汚染不純物を蓄積させることができない。1300°C以下の熱窒化による膜厚10Å以上の窒化シリコン膜上に膜厚約1500Åの気相成⾧ SiO_2 膜とその上の電極を設けたMISダイオードと、 Si 表面に約1500Åの膜厚を持つ熱酸化による SiO_2 膜とその上の電極を設けたMISダイオードのフラットバンド電圧の変動分(ΔV_{FB})を調べたところ、ダイオードへの直流印加電圧が±100Vの範囲内では、前者は後者の1/10程度の ΔV_{FB} を持ち、極めて安定な特性を持っていることが確認された。上記の如く1300°C以下の熱窒化による窒化シリコン膜は通常のゲート絶縁膜の膜厚1000~2000Åに比べて遙かに薄いものしか得られないから、ゲート絶縁膜を構成するためには、この上に気相成長等により実質的にゲート絶縁膜に必要な膜厚を持つ絶縁膜を被着しなければならない。また、 Si 基板の素子形成領域周囲はフィールド絶縁膜とする厚い絶縁膜を気相成長等により被着する必要があるが、従来のような熱酸化による SiO_2 膜厚は約1μmが限度であるのに対して、本発明では、1.5μmの膜厚とすることもでき、集積回路を構成した場合の配線容量およびボンディングパッド容量を低減

できる利点がある。

以上の如き、各種絶縁膜さらにゲート電極等の被着形成工程においては、本発明によればS i基板表面は金属イオンの移動を妨げ、しかも界面での汚染不純物の蓄積がない窒化シリコン膜で既に覆われているので、M I S型半導体装置の特性に決定的な影響を及ぼすゲート絶縁膜とS i基板との界面は汚染されることが全くない。さらに本発明による製造工程では、熱窒化による窒化シリコン膜生成に必要な処理工程において、フィールド絶縁膜が侵されるという従来の欠点は解消される。

以下、本発明実施例について説明する。第2図a～gは本発明の1実施例の各製造工程における基板断面を示す。本実施例は、ゲートの二層絶縁膜間の捕獲中心に電子あるいは正孔をトラップさせることにより、ゲートしきい電圧を変化させるM I S型不揮発性メモリーを製造する工程に本発明を適用した場合の例である。

初めに、従来の方法によって、P形S i基板11に選択拡散用マスク12を用いて、ソース、ドレイン拡散層13, 14を形成する。この場合拡散源として、A 8ドープトオキサイド15を用いれば、1時間のドライブインで表面濃度 $1.5 \times 10^{21}/cm^2$ 、深さ $0.45 \mu m$ のn⁺層を形成できる。この時、拡散領域のS iは酸化が進むため、表面酸化膜を全面に亘って除去した後のS i表面上において16, 17のようなn⁺領域を認識せしめる窓ができる。次に49%HF液で充分洗浄した後すばやく1270℃に加熱された窒素雰囲気中に置き20Åの膜厚の熱窒化S i₃N₄膜18を形成する。次に $2AlCl_3 + 3CO_2 + 3H_2 \rightarrow Al_2O_3 + 3CO + 6HCl$ の反応を利用してAl₂O₃膜19を約1000Åの厚さに付着させる。次にテトラエトキシシランの熱分解により約8000Åの膜厚のSiO₂膜20を付着し、ホトレジストをマスクにして、本発明によりチャネル領域のSiO₂のみをエッティングする。このエッティング液はフッ化アンモニウム飽和溶液等によればよく、常温ではAl₂O₃はエッティングされずに完全に残る。

次に、従来と同様の方法により、ソース、ドレインのコンタクト窓21, 22をあけ、Al₂Mo, Al₂O₃膜、SiO₂膜である。

W、多結晶シリコン等によって、ソース、ドレイン、ゲートの各電極23, 24, 25を形成し完成する。このようにして形成したM I S型不揮発性メモリーは、ソース23に対して正のパルスを5ゲート25に印加することでS i基板11から絶縁膜界面すなわち18と19の界面へ電子をトンネル効果により注入する。書込んだ情報を消去するには、反対符号のパルスをゲートに印加することでなされる。従来これと類似のメモリーがM N O SあるいはM A O S等の構成で出されているが、それらはいずれも記憶機能を支配する薄いSiO₂膜を選択酸化の手段で形成している。その方法では、フィールドオキサイドを形成した後、薄いSiO₂を生成するので、チャネル領域の充分なクリーニングをすることは難しい。従来のメモリー特性では、不完全な構造の薄いSiO₂膜のために、注入されたキャリアが消滅したりする現象がみられ、また多くとも 10^8 回以上の書き込み、消去のくりかえしに対しては犠牲が劣化する。しかし本発明により構成したメモリーでは、従来の薄いSiO₂膜に代えて、より構造緻密な熱窒化S i₃N₄膜を用い、S i表面のクリーニングも充分行うことができるため比較的劣化の少いことが明らかとなつた。さらに配線容量やボンディング25バツド容量の低減にはフィールド絶縁膜を気相成長等により厚く被着すればよい。

尚、前記実施例においては、熱窒化によるS i₃N₄膜とその上の第2絶縁膜であるAl₂O₃膜をS i基板のほぼ全面に設けたが、これらの絶縁膜はゲート部分のみに設けてもよく、その製造工程は種々の変更が可能である。また、本発明においては、熱窒化による窒化シリコン膜を除く他の絶縁膜として、従来知られている任意の絶縁膜を使用し得ることは勿論である。

35 図面の簡単な説明

第1図a～eは従来のM I S型半導体装置の製造工程を説明する図、第2図a～gは本発明実施例のM I S型半導体装置の製造工程を説明する図である。

40 図において、11はS i基板、14, 15はソース、ドレイン領域、18はS i₃N₄膜、19はAl₂O₃膜、20はSiO₂膜である。